

별첨 1 석사과정용 이수요건 양식

반도체학제전공 전공과목 이수요건 (석사과정용)	
논문석사	
<p>▣ 졸업이수학점: 총 33학점 이상 이수</p> <p>▣ 공통필수: 3학점 이상 및 1AU 이수</p> <ul style="list-style-type: none"> - CC500(Scientific Writing), CC510(전산응용개론), CC511(확률 및 통계학), CC512(신소재 과학개론), CC513(공업경제 및 원가분석학), CC522(계측개론), CC530(기업과 정신과 경영전략), CC531(특허분석과 발명출원), CC532(협력시스템설계) 중에서 택 1 하여 이수. - CC010 (리더십강좌), CC020(윤리및안전 I) 반드시 이수 <p>▣ 학제전공 필수선택: 3학점 이상 이수</p> <ul style="list-style-type: none"> - STE505(반도체 공정실험), EE571(전자회로특론), CS550(소프트웨어공학) 중에서 1과목 이상 반드시 이수해야 함. <p>▣ 학제전공 일반선택: 9학점 이상 이수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본 학제전공에서 지정한 일반선택 교과목 중에서 택 3하여 9학점 이상 이수 <p>▣ 소속학과 인정 전공교과목: 6학점 이상 이수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 소속학과/전공의 이수요건으로 인정한 전공교과목 중 택 2하여 6학점 이상 이수. <p>▣ 연구: 6학점 이상 이수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 반드시 STE998 석사인턴십 (1학점)을 포함하여 연구 6학점 이상 이수 - 논문연구, 개별연구, 세미나 등으로 6학점 이상 이수. (각 소속학과/전공의 연구과목으로 대체 가능함) <p>※ 학제전공에서 지정한 요건을 이수하는 동시에 소속학과의 이수요건을 만족시켜야 함.</p>	
교과석사	
상 동	
<p>□ 경과조치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대체교과목 변경 2009학년도 입학생부터 EE665(CMOS프론트-앤드공정기술), MS696(신소재공학특론(고급 반도체공정설계)) 중 한 과목만 수강, 2009학년도 이전 입학생은 EE665(CMOS프론트-앤드공정기술), MS635(반도체공정설계) 중 한과목만 수강해야함. 	

별첨 2 박사과정용 이수요건 양식

반도체학제전공 전공과목 이수요건 (박사과정용)

- **졸업이수학점:** 총 60학점 이상 이수

- **공통필수:** 3학점 이상 및 1AU 이수
 - 석사과정과 동일. (단, 석사과정에서 이수한 경우 이수하지 않아도 됨)

- **학제전공 필수선택:** 6학점 이상 이수
 - 석사과정에서 이수한 교과목을 포함하여 6학점 이수.
 - STE505(반도체공정실험), STE605(메모리및SoC기술), EE571(전자회로특론), CS550(소프트웨어공학) 중에서 2과목 이상 반드시 이수하여야 함.

- **학제전공 일반선택:** 12학점 이상 이수
 - 석사과정에서 이수한 교과목을 포함하여 12학점 이상 이수.

- **소속학과 인정 전공교과목:** 9학점 이상 이수
 - 각 소속학과/전공의 이수요건으로 인정한 전공교과목 중 석사과정에서 이수한 교과목을 포함하여 9학점 이상 이수.

- **연구:** 30학점 이상 이수
 - 반드시 STE999 박사인턴십 (1학점)을 포함하여 연구 30학점 이상 이수
 - 논문연구, 개별연구, 세미나 등으로 30학점 이상 이수.
(각 소속학과/전공의 연구과목으로 대체 가능함)

- **경과조치**
 - 대체교과목 변경
 - 2009학년도 입학생부터 EE665(CMOS프론트-엔드공정기술), MS696(신소재공학특론I(고급반도체공정설계)) 중 한 과목만 수강,
 - 2009학년도 이전 입학생은 EE665(CMOS프론트-엔드공정기술), MS635(반도체공정설계) 중 한과목만 수강해야함.